

Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2012CENGR

Hersteller-Teilenummer:	EPC2012CENGR
Hersteller / Marke:	EPC
Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 200V 5A BUMPED DIE
Datenblätter:	 EPC2012CENGR.pdf
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2650 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Teilenummer	EPC2012CENGR
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 200V 5A BUN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte
Teilstatus	2650 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die Outline (4-Solder Bar)
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 3A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Ta)

sein:

EPC2014C IC
EPC
EPC SMD

EPC2012CENGR Zugehöriges

EPC2012CENGR Datenblatt	EPC2012CENGR-Datenblätter	EPC2012CENGR PDF	EPC EPC2012CENGR
EPC2012CENGR-Komponenten	EPC2012CENGR-Verteiler	EPC2012CENGR-Bild	EPC2012CENGR-Teil
EPC2012CENGR Hersteller	EPC2012CENGR Bild	EPC2012CENGR Aktie	EPC2012CENGR Inventar
EPC2012CENGR Original	EPC2012CENGR garantiert	EPC2012CENGR RFQ	EPC2012CENGR Online bestellen